

UMX11N IMX11

アイソレーテッドミニモールドデバイス
Isolated Mini-Mold Device
高周波増幅用/RF Amplifier

● 特長

- 1) UMT(SC-70), SMT(SC-59) と同一体積に 2 個の高周波トランジスタが入っている。
- 2) UMT, SMT の自動装着機により、装着が可能である。
- 3) 各トランジスタの素子間は独立しているため相互干渉がない。

● Features

- 1) Two HF transistors are housed in the same volume as UMT(SC-70), SMT(SC-59).
- 2) The automatic mounting machine of UMT, SMT can be used for mounting.
- 3) No mutual interference exists between each transistor.

以下の特性は Tr₁, Tr₂ について共通です。

The following characteristics are common for Tr₁ and Tr₂.

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

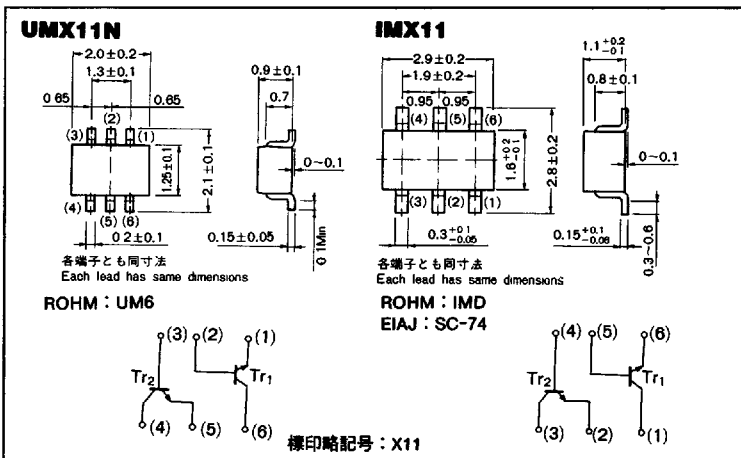
Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	25	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	20	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	4	V
コレクタ電流	I _C	20	mA
コレクタ損失	P _C	300 (TOTAL)*	mW
接合部温度	T _j	150	°C
保存温度範囲	T _{stg}	-55~150	°C

* ただし 1 素子当り 150mW を超えないこと。
However 150mW should not be exceeded per element.

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・ベース降伏電圧	BV _{CB0}	25	—	—	V	I _C =10 μA
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV _{CEO}	20	—	—	V	I _C =1mA
エミッタ・ベース降伏電圧	BV _{EBO}	4	—	—	V	I _E =10 μA
コレクタレキ断電流	I _{CB0}	—	—	0.5	μA	V _{CB} =20V
エミッタレキ断電流	I _{EBO}	—	—	0.5	μA	V _{EB} =3V
直流電流増幅率	h _{FE}	39	—	180	—	V _{CE} /I _C =6V/1mA
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE (sat)}	—	0.1	—	V	I _C /I _B =10mA/1mA

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 標準品・準標準品一覧表 (○: 準標準品)

Type	包装名	テーピング			
	記号	TL	TR	T108	T109
	基本発注単位(個)	3000	3000	3000	3000
UMX11N		○	○	—	—
IMX11		—	—	○	○

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

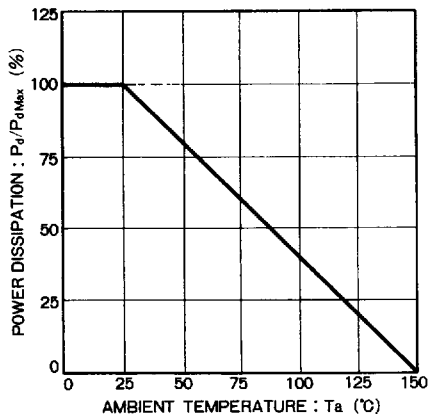


Fig.1 電力軽減曲線

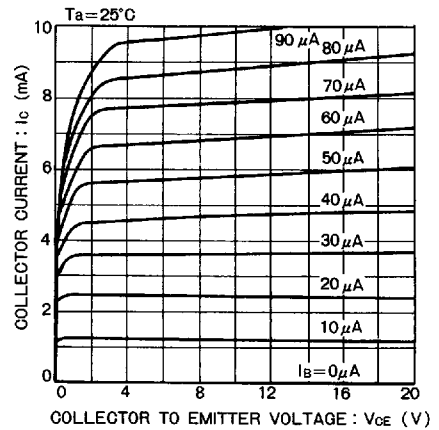


Fig.2 エミッタ接地出力静特性

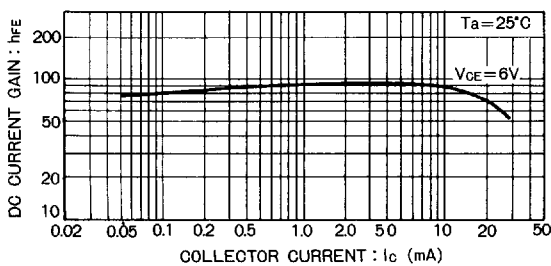


Fig.3 直流電流増幅率—コレクタ電流特性

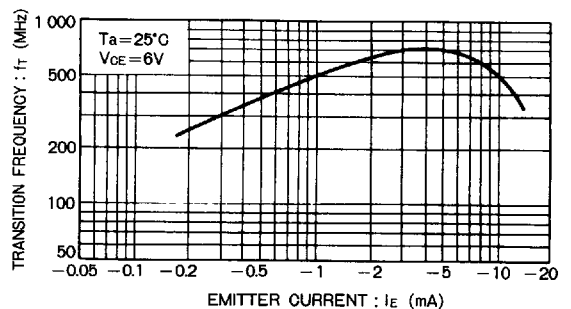


Fig.4 利得帯域幅積—エミッタ電流特性

トランジスタ 2素子内蔵6端子タイプ

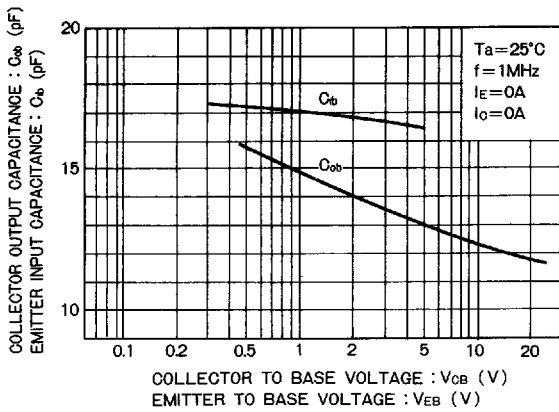


Fig.5 入出力容量—電圧特性

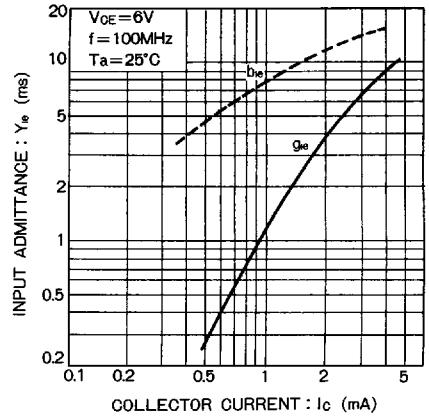


Fig.6 入力アドミタンス—コレクタ電流特性

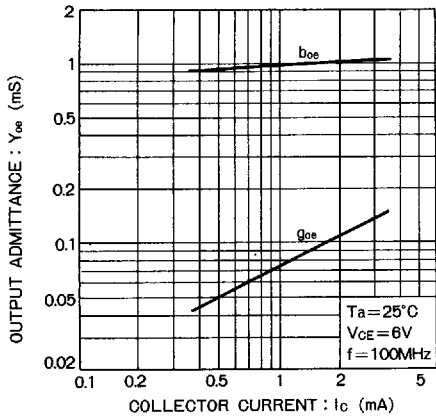


Fig.7 出力アドミタンス—コレクタ電流特性

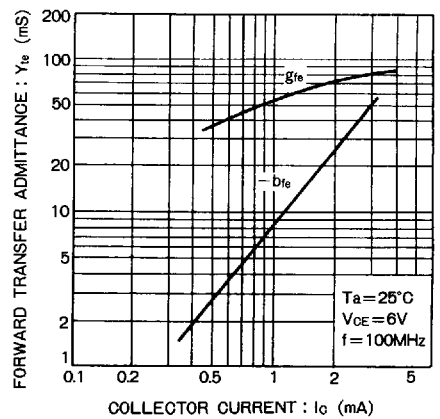


Fig.8 順伝達アドミタンス—コレクタ電流特性

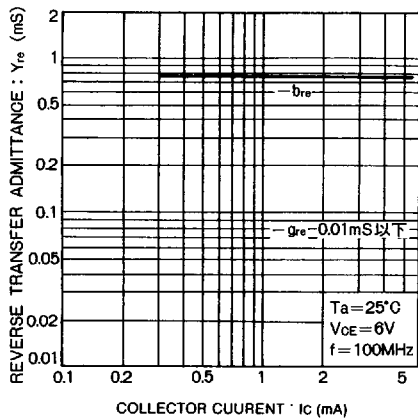


Fig.9 逆伝達アドミタンス—コレクタ電流特性